

Vortragsprogramm des Netzwerks Leistungselektronik Schleswig-Holstein ,Leistungselektronik in Schleswig-Holstein‘

auf der Husum Wind am 12.09.2019 von 11:30 Uhr bis 13:50 Uhr

(Vortragssprache deutsch)

11:30 Uhr Vortrag 1

Prof. Holger Kapels, ISIT:

"Das Netzwerk Leistungselektronik Schleswig-Holstein"

Das Netzwerk bietet die Basis die Akteure in diesem Bereich durch Vernetzung und Austausch zu stärken, Forschungsprojekte abzustimmen und vorzubereiten und die Bedeutung der Leistungselektronik für die Öffentlichkeit darzustellen.

11:45 Uhr Vortrag 2

Ralf Duckert und Daniel Klose, DSN:

"Leistungselektronik in Schleswig-Holstein - Stand und Perspektiven"

DSN stellt die im Auftrag des Netzwerkes entstandene Studie zur Leistungselektronik in Schleswig-Holstein vor. Untersucht wurden Status und Perspektiven zu den agierenden Unternehmen, den Entwicklungsthemen, der Nachwuchsgewinnung, den Förderprojekten und der Netzwerkarbeit.

12:25 Uhr Vortrag 3

Dr. Georg Pangalos, ISIT:

"Aktive Oberwellenkompensation mit modellbasierter Regelung"

Durch den wachsenden Anteil erneuerbarer Energiequellen steigt der Oberwellenanteil im Stromnetz an. Eine Lösung zur Kompensation liefern passive und aktive Netzfilter. In dem Vortrag wird die Verwendung modellbasierter Regelungsmethoden für aktive Netzfilter vorgestellt und einer Standard-Regelung gegenübergestellt.

12:50 Uhr Vortrag 4

Prof. Marco Liserre, CAU:

"Integration von Windenergieanlagen im Stromnetz durch Leistungselektronik"

Windenergieanlagen, über Leistungselektronik an das Stromnetz angeschlossen, führen zu neuen Herausforderungen hinsichtlich der Stabilität des Netzes. Im Fokus stehen dabei Regulationsinteraktionen zwischen WEA und Netzanschluss, die Synchronisierung netzgebundener Umrichter und die Identifizierung der elektrischen Eigenschaften des Netzes.

13:20 Uhr Vortrag 5

Heiko Züge, ISIT:

"1200 V-IGBTs und GaN-Bauelemente der nächsten Generation für die Energiewende"

Die Entwicklung energiesparender Bauelemente ist einer der Schlüssel zur Energiewende. Das Fraunhofer ISIT erforscht deshalb neben IGBTs aus Silizium auch neuartige Leistungsbaulemente aus Galliumnitrid, da dieses Halbleitermaterial noch optimalere Eigenschaften hat.

13:50 Uhr Ende der Veranstaltung